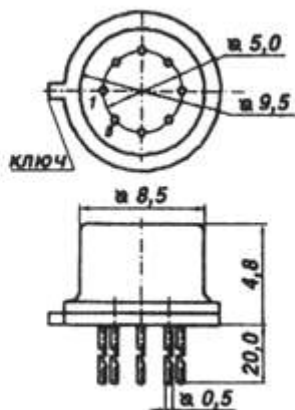


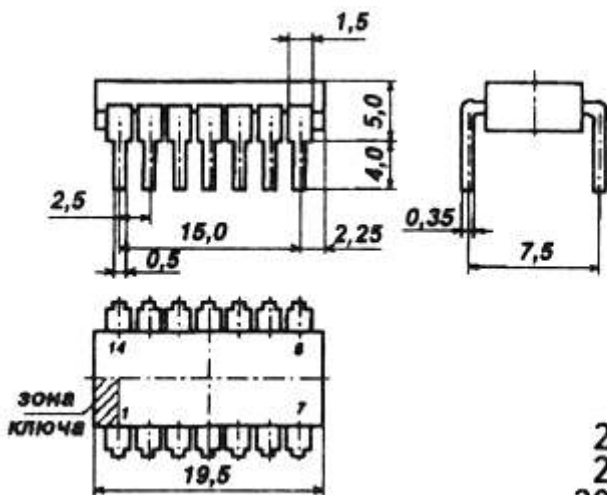
Микросхемы представляют собой матрицу из двух n-p-n транзисторов (для построения дифференциальных усилителей). Корпус типа 301.8-2, масса не более 1,3 гр и типа 201.14-1, масса не более 1,0 гр.

Корпус ИМС К159НТ1А-Е

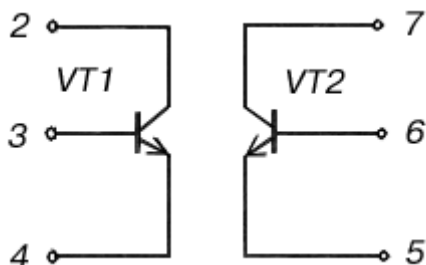


301.8-2
301.8-2.02

Корпус ИМС КР159НТ1А-Е



201.14-1
201.14-2
201.14-13



Электрическая схема

1,8 - свободные;
2 - коллектор транзистора VT1;

- 3 - база транзистора VT1;
- 4 - эмиттер транзистора VT1;
- 5 - эмиттер транзистора VT2;
- 6 - база транзистора VT2;
- 7 - коллектор транзистора VT2;

Электрические параметры

1	Разность напряжений эмиттер-база транзисторов 159НТ1А-В 159НТ1Г-Е	не более 3 мВ не более 15 мВ
2	Прямое падение напряжения эмиттер-база при $I_E=1$ мА	0,55...0,75 В
3	Обратный ток коллектор-база	не более 200 нА
4	Обратный ток эмиттер-база	не более 500 нА
5	Ток утечки между транзисторами VT1 и VT2 при $U=20$ В	не более 20 нА
6	Коэффициент усиления по току при $U_{КБ}=5$ В, $I_E=1$ мА 159НТ1А,Г 159НТ1Б,Д 159НТ1В,Е	20...80 60...180 более 80
7	Емкость эмиттера на частоте 10 мГц	не более 5 пФ
8	Емкость коллектора на частоте 10 мГц	не более 4 пФ

Предельно допустимые режимы эксплуатации

1	Напряжение коллектор-база	20 В
2	Напряжение эмиттер-база	4 В
3	Напряжение между транзисторами	20 В
4	Ток коллектора постоянный	10 мА
5	Ток коллектора импульсный $t_{и}=30$ мкс	40 мА
6	Рассеиваемая мощность	50 мВт

Зарубежные аналоги

2N4042-2N4045

Литература

Интегральные микросхемы и их зарубежные аналоги: Справочник. Том 2./А. В. Нефедов. - М.:ИП РадиоСофт, 1999г. - 640с.:ил.